無機ナノ結晶表面の光誘起配位子脱離反応を用いた 微細パターニング技術の創製

M22助自33

代表研究者 小林洋 一 立命館大学 生命科学部 教授 Yoichi Kobayashi Professor, College of Life Sciences, Ritsumeikan University

Organic-inorganic nanohybrids using semiconductor nanocrystals (NCs) coordinated with aromatic organic molecules have been widely studied in the fields of optoelectronic materials, such as solar cells, photocatalysis, and photon upconversion. Organic ligands (mostly longchain alkyl groups) on the surface of NCs are essential for the synthesis of highly functional colloidal nanocrystals. However, they significantly reduce the electrical conductivity and electron transfer efficiency of NC-integrated films. Although post-film treatments improve the above characteristics, it is difficult to spatially selectively treat only specific areas to create finely integrated circuits. The desorption of ligands by photoirradiation seems to be an effective method for spatially selective treatment. However, such research and subsequent photochemical reactions involving organic ligands are completely absent in composite nanomaterial systems. This is largely due to the fact that coordination bonds of ligand molecules are usually assumed to be stable during optical processes. However, this assumption is not always valid. In this study, we demonstrate that the coordination bonds between ligand molecules and NCs by carboxyl groups are displaced quasi-reversibly by light irradiation using zinc sulfide (ZnS) NCs coordinated with perylenebisimide (PBI) as a model system. Time-resolved spectroscopy over a wide range of time from tens-of femtosecond to second timescales and density functional theory calculations show that the photoinduced ligand displacement is driven by ultrafast hole transfer from PBI to ZnS NCs, and that the dissociated radical anion of PBI survives over the second timescale. Photoinduced ligand displacements are important to be considered in various organic-inorganic nanohybrids and offer a possibility of NCs covered by non-photoresponsive organic ligands for advanced photofunctional materials such as advanced photocatalysts that possess both colloidal stability and high reactivity, as well as photopatterning capability of conductive circuits using NC solid films.

研究目的

コロイド半導体ナノ結晶は高機能のナノ結 晶を精密に合成でき、溶液による塗布膜形成 が可能であることから、フレキシブル太陽電池、 LED、電界効果トランジスタ、熱電材料など、 さまざまな次世代光エレクトロニクスデバイス として注目されている。ナノ結晶表面に存在す る有機配位子は、高機能なナノ結晶合成にお いて必要不可欠である一方、ナノ結晶集積膜 の電気伝導性や電子移動効率を著しく低下さ せることから、膜形成後にヒドラジンなど反応 活性な溶媒で処理することにより表面保護剤 を除去する必要がある。このような溶媒処理は 均一膜を作成するにおいては有効である一方、 特定の部位のみを空間選択的に処理し、微細 な集積回路などを作成することは難しい。空 間制御としての有効手段として光が挙げられる が、これまでにさまざまなナノ材料が創出され てきたにもかかわらず、そのような現象の報告 例は皆無であった。

近年我々は、可視光応答色素として知られ るペリレンビスイミド (PBI)をカルボキシ基に よって硫化亜鉛 (ZnS)ナノ結晶表面に配位さ せた複合ナノ材料において、可視光照射に伴 いPBIがナノ結晶から脱離する現象を見出して いる。本研究の目的は、PBIとZnSナノ結晶の 光脱離過程を時間分解分光をと量子化学計算 を用いて詳細に解析し、光配位子脱離を導電 性微細加工技術に応用するための基盤を確立 することである。

概 要

芳香族有機分子を配位させた半導体ナノ結 晶を用いた有機-無機ナノハイブリッドは、太 陽電池、光触媒、光子アップコンバージョン などの次世代光電子機能材料として注目され ている。ナノ結晶表面の有機配位子(主に長鎖) アルキル基)は、高機能コロイドナノ結晶の合 成に不可欠である。しかし、有機配位子はナ ノ結晶集積膜の電気伝導性と電子移動効率を 著しく低下させる。成膜後の処理によって電 気伝導性は改善されるが、特定の領域のみを 空間的に選択的に処理して微細な集積回路を 作ることは難しい。空間選択的な処理としては 光照射による配位子脱離が有効な方法と考え られる一方、そのような現象はこれまで経験的 にのみ知られており、詳細な研究はこれまでに 皆無であった。本研究では、カルボキシ基を 介してナノ結晶表面に配位したペリレンビスイ ミド (PBI) が硫化亜鉛 (ZnS) ナノ結晶表面に

配位した複合ナノ材料(PBI-ZnS)をモデル物 質として、PBIが可視光照射によって脱離し、 10秒程度で再度ナノ結晶表面に配位すること を初めて明らかにした。

PBI-ZnSのクロロホルム溶液において、530 nmの励起パルスでPBIを選択的に励起したと きの時間分解インパルシブ誘導ラマン散乱測定 において、励起後数十フェムト秒以内にPBIラ ジカルアニオンに由来する成分が観測された。 ZnSの価電子帯はPBIの最高非占軌道(HOMO) よりも電位が正であり、ZnSの価電子帯からの PBIのHOMOへの電子移動は考えづらい。一 方、ZnSのZn欠損に由来する正孔捕捉準位(電 子ドナーとして作用)はPBIのHOMOよりも負 電位側に存在することから、ZnSのドナー性の 欠陥準位からPBIのHOMOへと超高速電子移 動が起きていることが示唆された。この電子移 動過程はモデルナノクラスターをもとに行った 密度汎関数計算からも支持された。

530nmの励起パルスでPBI部位を選択的に 励起したときの可視光領域の過渡吸収スペク トル測定において、励起直後に電子移動に由 来するPBIの誘導放出シグナルの減少が観測さ れ、その後数百ピコ秒からナノ秒にかけてブ ロードな過渡吸収バンドが600nmに観測され た。ブロードなシグナルはPBIとZnSの相対割 合に依存して生成速度、生成量ともに変化す ることから、光励起されたPBIとナノ結晶表面 にある別のPBIとの相互作用であることが示唆 された。ナノ結晶表面に存在するPBI同士が相 互作用するためには、配位している状態で既に 隣に存在するか、脱離して拡散するかの二つの 可能性がある。剛直なポリマーにPBI-ZnSを分 散させて同様に過渡吸収スペクトルを測定した ところ、ブロードな過渡吸収バンドがほとんど 観測されなかった。この結果より、600 nmの ブロードな過渡吸収バンドはPBIが励起に伴っ

てナノ結晶表面から脱離し、拡散を経てナノ 結晶表面の別のPBIと会合したことによって生 成したものであることが明らかになった。

光照射でPBIが脱離するということは、別の PBIとの会合をしなかったものの一部は溶液中 で分散し、長寿命の間存在していることが示 唆された。秒オーダーの過渡吸収分光測定よ り、予想通りPBIラジカルアニオンに由来する 成分が数秒以上の時間スケールで観測された。 光生成したPBIラジカルアニオンは10秒程度で ほぼすべてが元の状態に戻り、PBIラジカルア ニオンは6回程度繰り返し光照射を行っても全 く同じ量のシグナルが観測されたことから、ほ とんどのPBIが脱離後に10秒程度でナノ結晶に 再配位していることが示唆された。一方、ナノ 結晶表面の全く同じ位置に再配位していると は考えづらいことから、我々はこの脱離、再配 位を擬可逆的過程と結論した。光脱離のメカ ニズムを明らかにするため、再度モデルクラス ターを用いてS0、S1状態における再安定構造を 計算したところ、S1に遷移することにより、配 位部位であるカルボキシ基のO原子とZn原子間 の距離はほとんど変化しない一方、配位してい るZn原子がナノ結晶そのものから脱離方向に シフトすることが明らかになった。最近接のZn 原子を含めたPBI部位とそれ以外のナノ結晶部 位の間のクーロン力は光励起により1/10程度 に減少しており、この配位力の大幅な減少が 脱離に起因していることが示唆された。

ナノ結晶表面の配位子の光脱離は様々な有 機-無機ナノハイブリッドにおいて重要な現象 である。この現象はナノ材料化学分野の基礎 学理において重要であるだけでなく、適切に制 御できれば、コロイド安定性と高い反応性を 併せ持つ光触媒や、ナノ結晶固体膜を用いた 導電性回路の光パターン形成など、様々な新 しい光機能材料となる可能性がある。

本 文

イントロダクション

コロイド半導体ナノ結晶の表面に存在する 有機配位子は、ナノ材料の分散性、光機能特 性、電気伝導性など、さまざまな特性に重要 な役割を果たす。したがって、ナノ材料の機 能を制御し、最適化するためには、有機配位 子の基本的な特性を理解することが重要であ る。さまざまな有機配位子を用いた有機-無機 複合ナノ材料が近年活発に研究されており、 太陽電池、光触媒、フォトンアップコンバー ジョン、高次励起状態を利用した非線形光機 能材料など、さまざまな次世代光電子機能材 料として注目されている。これらの材料研究は 盛んに行われている一方、ほぼすべての研究の 物性評価において、有機配位子がナノ結晶表 面に安定に存在していると仮定している。しか し、こうした仮定は必ずしも妥当ではないこと が近年の研究から示されている。

近年いくつかの研究グループが核磁気共鳴 (NMR)分光法を用いてナノ結晶の表面有機 分子の配位過程を系統的に明らかにしている。 例えば、Owenらは溶液中のCdSeナノ結晶表面 に配位したオレイン酸が、オレイン酸カドミウ ムとの熱平衡状態として存在することを明らか にしている^[11]。Asburyらは、PbSナノ結晶の励 起状態において、オレイン酸のカルボキシ基の 結合形態が変化することを時間分解赤外分光 測定により明らかにしている^[21]。しかし、この ような光励起に伴う結合様式の変化に関する 研究は彼らの研究例のみであり、結合様式が 変わってからどのような化学反応引き起こされ るかなどの研究はこれまでに皆無であった。

有機配位子はナノ結晶の安定性にとって重 要であるが、しばしば効率的な光触媒反応を 阻害し、ナノ結晶固体膜の導電性を低下させ る。もし有機配位子を光によってオンデマンド で脱離・置換できれば、従来のナノ結晶の特 性を超えた高度な光機能性材料を開発できる。 例えば、ナノ結晶の活性面をオンデマンドに露 出させて触媒反応を行うことができる光触媒 や、光によるナノ結晶固体膜の伝導回路パター ニングなどが挙げられる。したがって、有機-無機ナノハイブリッド系の配位子特性を探索 することは、材料科学の様々な分野において重 要である。

本稿では、カルボキシル基を有するペリレン ビスイミド (PBI) が配位した硫化亜鉛 (ZnS) ナ ノ結晶 (PBI-ZnS) をモデル物質として、半導 体ナノ粒子表面に配位した芳香族配位子が可 視光照射によって擬可逆的に脱離する現象の 研究について紹介する。フェムト秒から秒の時 間分解光学分光測定と密度汎関数理論 (DFT) 計算を組み合わせて、光物理学的および光化 学的過程を詳細に明らかにした^[3]。

結果と考察

粉末X線回折と透過型電子顕微鏡 (TEM) 測 定から、ZnS NCの結晶構造は閃亜鉛鉱型、平 均直径は4.42±0.19 nmであることが示された。 PBIのクロロホルム溶液の458、490、526 nmの 特徴的な吸収ピークはS₀-S₁遷移の振電遷移に 由来する(図2)。ZnSナノ結晶のクロロホルム溶 液は340 nmより短い吸収帯があり、第一励起 子ピークは313 nm付近に位置する。PBI-ZnSの クロロホルム溶液では、PBIに由来する吸収帯 がわずかに長波長シフト(526 nmから531 nm)、 ブロード化した。これは、PBIとZnSナノ結晶 間の電子的相互作用、不均一性の増大、分子 周囲の誘電率の変化(クロロホルム、ZnSの誘電 率はそれぞれ4.8、8.3)などによると考えられる。

PBI濃度を2.6×10⁻⁶Mに固定したクロロホ ルム溶液にZnSナノ結晶が溶解したクロロホル ム溶液を徐々に加えて、PBI部位の吸収スペク トルの変化からPBI-ZnSの会合過程を評価し た。ZnSナノ結晶の濃度が低いときにおいても、 ZnSナノ結晶の濃度が高くなるにつれてPBIの 吸収スペクトルが長波長側にシフトし、ZnSナ ノ結晶あたりのPBIの数(PBI/ZnSナノ結晶)が 約7.0になるとスペクトルシフトが止まった。さ らに、プロトンNMR測定において、PBIの重ク ロロホルム溶液中に少量のZnSナノ結晶溶液を 添加すると、PBIに由来するピークが消失した。 これらの結果は、低濃度のZnSナノ結晶であっ てもPBIの大部分がZnSナノ結晶表面に吸着す ることを示している。

PBIおよびPBI-ZnSのクロロホルム溶液の蛍



図1 (a) PBIの分子構造および (b) PBI-ZnSの擬可逆的な光配 位子脱離過程



図2 PBI、ZnSナノ結晶、PBI-ZnS(PBI/ZnSナノ結晶 = 7.0)
のクロロホルム溶液の室温における定常光吸収スペクトル

光スペクトルおよび相対蛍光量子収率(Φ)をエ タノール中のローダミン6Gを基準として測定 した(Φ=0.91)。試料の相対発光量子収率は、 PBIおよびPBI-ZnSでそれぞれ0.88および0.25 であった (PBI/ZnSナノ結晶 = 7.0)。PBI-ZnSの 発光量子収率の大きな減少は、ZnSナノ結晶が 光誘起電荷移動などによってPBIの消光剤とし て働くことを示唆している。

PBI-ZnSの電子状態に関する知見を得るた め、PBI-ZnSのモデル分子として[PBI-Zn25S31]-を設計し、基底状態(S₀)、第一励起状態(S₁) の最適化構造、エネルギー準位、およびそれ らの軌道をDFT計算により求めた。図3にS1の 最適化構造における励起電子と正孔が占有す る軌道を示す。励起電子が占有する軌道(図3 上部)はPBIの周りに局在している一方、正孔 が占有する軌道(図3下部)は光励起がPBIの内 で起こっているにもかかわらず、ZnS部分上に も非局在化している。さらに、S₀と比較してS₁ では、PBI部分の電荷がより負になるのに対し、 ZnS部分の電荷はより正になることが明らかに なった。つまり、計算結果もPBI-ZnSがPBIの 光励起後に正孔がPBIからZnSナノ結晶に移動

電子



図3 [PBI-Zn₂₅S3₁]-のS₁おける最適化構造における、励起 電子と正孔が占有する軌道

することを示すことがわかった。

バルクZnSの価電子帯 (VB)のエネルギー端 はPBIの最高非占軌道(HOMO)よりも電位が 正になっている一方、ZnS表面のZn空孔などの 欠陥準位はVB端の電位よりも負に位置する。 つまり、ZnSのZn空孔などの欠陥準位が電子移 動の要因となっていると考えられる。量子化学 計算で設計した[PBI-Zn₂₅S₃₁]⁻はZn原子より もS原子の数が相対的に多く、[PBI-Zn₂₅S₃₁]⁻ の表面にはZn原子が欠けて空孔とみなせる部 分が複数存在する。このようなZn空孔軌道は PBIのHOMOよりも負電位側に現れ、PBIから Zn₂₅S₃₁への励起状態の正孔移動を引き起こす 要因となっていると考えられる。

PBI-ZnSの励起状態ダイナミクスを調べるた めに、時間分解インパルシブ誘導ラマン分光法 (TR-ISRS)を行った。530 nmの励起パルス(60 fs)と650-940 nmの範囲のラマンポンプおよび観 測パルス (7.1 fs) を用い、後者はPBIのS_n-S₁励 起状態吸収と厳密に共鳴した。TR-ISRSを用い て得られたクロロホルム中のPBI-ZnS (PBI/ZnS ナノ結晶=6.8)のフェムト秒時間分解ラマンス ペクトルを図4に示す。光励起直後の1597cm⁻¹ に強いバンドが観測され、拡大したスペクトル では低周波数領域にさらにいくつかのバンドが 観測された。このスペクトルの特徴は、基本的 にPBIのS」のものと同じであり、観測されたラマ ンバンドは主にZnSナノ結晶上のPBIのS1に帰 属される。一方、1542cm⁻¹の強いバンドはPBI-ZnSのみに特徴的なものであり、これはPBIラジ カルアニオンのラマンスペクトルと一致する(図 4b)。よって、実験と理論計算の両方から、光 照射によってPBIからへのZnSナノ結晶への正 孔移動が起こることを示している。

超高速の正孔移動によって誘起される物理・ 化学過程を明らかにするため、530nmの励起 光でPBIを選択的に励起した際のクロロホルム 中のPBI-ZnS(PBI/ZnSナノ結晶=7.0)のサブ ピコ秒からナノ秒の可視領域の過渡吸収スペ クトルを測定した。PBI部位に対応する基底状 態のブリーチと誘導放出に由来する負のシグナ ルが465-590 nmに観察された一方、PBI-ZnSの 基底状態のブリーチに対する誘導放出の相対 的な信号強度はPBIのものよりも小さかった。 さらに、数十ピコ秒からナノ秒の時間スケール で600nm付近にブロードな過渡吸収バンドが 徐々に現れた。このような特徴は、電子移動 が起こらないPBI単体やPBIを配位したCdSナ ノ結晶では観察されない。つまり、これらのシ グナルはPBIからZnSナノ結晶への超高速の正 孔移動によって、何らかの光物理的または光 化学的過程が誘起されていることを示唆する。 PBIとZnSナノ結晶の比(PBI/ZnSナノ結晶) が異なるPBI-ZnSでは、600nmに同様のブロー ドな過渡吸収バンドが観察された一方、PBI/ ZnSナノ結晶比の減少に伴ってブロードな過 渡吸収バンドの信号強度が減少し、また生成 速度が下がった(図5b)。もし過渡吸収バンド がPBIとZnSナノ結晶の1対1の相互作用に由 来するのであれば、形成速度や信号強度はZnS ナノ結晶あたりのPBIの数に依存しない。した がって、これらの結果は600 nmのブロードな 過渡吸収バンドが、光生成したPBIのラジカル アニオンと別のPBIとの相互作用に由来するこ とを示唆している。PBI凝集体に関する過去の

(a) ∆T (ps) ×30 500 (5 / div.) power (1.0 뵤 0.5 1515 ·1542 1371 256 292 0.1 -5.0 1700 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Wavenumber (cm-1) (b) PBIラジカル (a.u.) 7 power PBI-ZnS (1 ps) Ē PBIS₁ (1 ps) 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Wavenumber (cm⁻¹)

図4 (a) PBI-ZnS (PBI/ZnS ナノ結晶 = 6.8) ノクロロホルム 時間分解ラマンスペクトルと (b) PBIのS1やPBIラジカ ルアニオンのスペクトルとの比較



図5 PBI-ZnS (PBI/ZnS ナノ結晶 = 7.0)のクロロホルム溶液の(a) 過渡吸収スペクトルおよび(b) 過渡吸収ダイナ ミクス 報告でも同様の過渡吸収バンドが報告されて おり^[4]、これらの仮説を支持する。

上述したように、NMR分光および定常光分 光測定に基づくと、PBI-ZnSの溶液中には遊離 のPBIはほとんど存在しない。光励起したPBI が別のPBIと相互作用するためには、配位にお いて極めて近接しているか、PBIがナノ結晶表 面から脱離し、拡散する必要がある。この仮説 を確かめるため、剛直なポリマーとして知られ るポリメタクリル酸メチル (PMMA) にPBI-ZnS (PBI/ZnSナノ結晶=7.0)を分散させたポリマー 膜を作製し、同様の条件で過渡吸収スペクト ルを測定した。PBI-ZnSのポリマー膜の励起後 2.5ナノ秒後の過渡吸収スペクトルは600 nmの ブロードな吸収帯がほぼ存在しなかったことか ら、PBIのラジカルアニオンの拡散の抑制により PBIの会合体の形成が抑制されることがわかっ た。つまり、光励起したPBIがナノ結晶表面か ら脱離していることが示された。

光生成したPBIラジカルアニオンの一部は別 のPBIと会合体を形成せず、媒質中に拡散し、 長寿命の電荷分離状態が観察されることが予 想される。これを確かめるため、窒素雰囲気下 で525nmの連続光(54 mW/cm²)を20秒間照射 した後、クロロホルム中のPBI-ZnS(PBI/ZnS ナノ結晶=6.8)の過渡吸収スペクトルをミリ秒 から秒の時間スケールで測定した(図6a)。

溶液中で有機分子が光生成する従来の電荷 分離状態の寿命はせいぜいマイクロ秒領域であ り、光分解を除いてミリ秒より遅いダイナミク スの光化学反応は観察されない。しかし、クロ ロホルム中のPBI-ZnSでは、可視光照射後、秒 単位の時間スケールでもPBIラジカルアニオン に由来する明確な過渡吸収シグナルが観測さ れた。以前の研究で示されたように、ZnSナノ 結晶のトラップされた正孔は環境に依存してミ リ秒から秒のスケールで存在できるため、PBI- ZnSへの可視光照射によって超長寿命の電荷 分離状態が形成されたことを示唆している。 ZnSナノ結晶表面に結合したPBIでは、電子と 正孔の間の距離が短く、再結合速度が速いた め、このような長寿命の電荷分離状態は生成 できない。したがって、PBIの長寿命ラジカル アニオンが秒スケールで存在することは、配位 したPBIが光誘起正孔移動によってZnSナノ結 晶表面から脱離していることを示している。過 渡吸収スペクトルで観測された600nmのブロー ドな吸収帯は図6aでは観測されず、PBI会合体 が解離または緩和して中性のPBIになったと考



Figure 6 (a) Time evolutions of the absorption spectra of PBI-ZnS (PBI/ZnS ナノ結晶 = 6.8) in chloroform excited at 525 nm with CW light (54 mW/cm²) for 20 s at room temperature. (b) The time profile of the photoinduced absorbance change of PBI-ZnS (PBI/ZnS ナノ結晶 = 1.7) probed at 710 nm in chloroform during the repeated irradiation of a 525-nm CW light (57 mW/cm²) for 20 s.

えられる。

100ナノ秒における710 nmの過渡吸収シグナ ル強度より、ZnSナノ結晶からのPBIの光脱離 の量子収率は1.6%と算出された。100ナノ秒 以前のよりも早い電荷再結合の寄与を考慮す ると、この量子収率はさらに大きくなる。量子 収率はそれほど大きくないが、連続波を長時間 照射する場合、この過程を無視することはでき ない。

発生したシグナルのほとんどは数秒以内で元 の状態へと戻るが、ブリーチシグナルはわずか に数十秒以上残る(図6a)。長寿命の電荷分離 状態は、ZnSナノ結晶表面に配位しているPBI が少ないPBI-ZnSサンプルでも観察された (PBI/ ZnSナノ結晶=1.7、図6b)。さらに、いずれの 試料(PBI/ZnSナノ結晶=6.8および1.7)におい ても、長寿命の電荷分離状態を繰り返し生成 することができ、生成した光誘起吸光度変化の 最大値は全く減少しなかった(図6b)。図6aに 示すPBIのラジカルアニオンの寿命は11秒であ るが、図6bに示すように、減衰の寿命は実験 ごとにわずかに異なる。クロロホルム中のPBI-ZnSの吸収スペクトルは、525 nmの光 (54mW/ cm²)を60秒間照射した後の吸収スペクトルと ほぼ同じであり、ZnSナノ結晶およびPBIの両部 位においてスペクトルシフトは観察されなかっ た。供給された光子の総数は溶液中に存在す るPBIの分子数の300倍以上であったことから、 このような照射条件下では、もし不可逆的な脱 離が起きている場合には、秒スケールでの光 化学反応を繰り返し観察することはできないは ずである。また、光照射後のZnSナノ結晶の吸 収端が全く同じであったことから、光照射中の ZnSナノ結晶のサイズは一定であり、ZnSナノ 結晶の光誘起溶解は無視できるほど小さいこと がわかった。一方、脱離した配位子はZnSナノ 結晶の全く同じ位置に戻るとは考えづらく、他

の表面欠陥などと再結合する可能性は十分に 考えられる。したがって、これらの結果は、配 位したPBIの光誘起変位がほぼ可逆的であるこ とを示しており、我々はこれらの過程を擬可逆 的と結論付けた。

有機配位子の光脱離メカニズムを明らかにす るため、PBIに最近接したZn₂₅S₃₁のZn原子に着 目して、S₀およびS₁における [PBI-Zn₂₅S₃₁]⁻の 電荷分布と分子構造をさらに詳細に解析した (図7)。その結果、最近接Zn原子とPBIの結合 カルボキシル基(図7の青)間の距離はS₀とS₁で はほぼ同じである一方、最近接Zn原子とZnS 部分の残りの部分(図7の赤)との間の距離が S₁では大幅に伸びることが明らかになった。さ らに、最近接Zn原子を含むPBI部位と残りの ZnS部位との正味の電荷の合計は、S₀とS₁で大 きく変化し、S₀では+0.47と-1.10であるのに対 し、S₁では+0.09と-0.70である。2つの領域間



図7 [PBI-Zn25S31] -の (a) S0、(b) S1における最適化構造と 結合距離

の単純なクーロン力を計算すると、S」における クーロン力がSoのものと比べて0.092倍に減少 することがわかった。つまり、PBI-ZnSの光脱 離現象は、光励起に伴う配位子とナノ界面と の間の配位力の大幅な減少によって起こるこ とが明らかになった。さらに、この計算結果は、 ZnSナノ結晶の表面に配位したPBIが最近接Zn 原子と共に解離することを示唆している(図1)。 基底状態ではこのようなナノ界面の配位子と 金属錯体との平衡が報告されている一方、光 励起においてこのような過程を観測した例は今 までにない。今後、組成、配位官能基の種類、 環境、添加物、温度など、今後様々な条件で の光脱離過程を解析することにより、この新し い現象の基礎学理の構築とそれらを用いた応 用展開が望まれる。

参考文献

- Anderson, N. C.; Hendricks, M. P.; Choi, J. J.; Owen, J. S. Ligand Exchange and the Stoichiometry of Metal Chalcogenide Nanocrystals: Spectroscopic Observation of Facile Metal-Carboxylate Displacement and Binding. J Am Chem Soc 2013, 135 (49), 18536-18548. https://doi.org/10.1021/ja4086758.
- [2] Kennehan, E. R.; Munson, K. T.; Doucette, G. S.; Marshall, A. R.; Beard, M. C.; Asbury, J. B. Dynamic Ligand Surface Chemistry of Excited PbS Quantum Dots. *Journal of Physical Chemistry Letters* 2020, *11* (6), 2291-2297. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c00539.
- [3] Yoshioka, D.; Yoneda, Y.; Chang, I. Y.; Kuramochi, H.; Hyeon-Deuk, K.; Kobayashi, Y. Quasi-Reversible Photoinduced Displacement of Aromatic Ligands from Semiconductor Nanocrystals. ACS Nano 2023, 17 (12), 11309-11317. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12578.
- [4] Kang, S.; Kim, T.; Hong, Y.; Würthner, F.; Kim, D. Charge-Delocalized State and Coherent Vibrational Dynamics in Rigid PBI H-Aggregates. J Am Chem Soc 2021, 143 (26), 9825-9833. https://doi.org/10.1021/jacs.1c03276.

今後の研究の見通し

本研究は、有機-無機複合ナノ材料研究にお いてこれまで見過ごされてきた根幹的な現象を 見出したものであり、ナノ材料化学や光化学分 野において重要な知見である。それだけでなく、 ナノ結晶表面の有機配位子はナノ結晶の分散 性、触媒活性、電気伝導性、発光特性などの さまざまな機能を決めることから、コロイド粒 子の分散性、触媒活性、発光特性などを光で 制御できる光触媒や、ナノ結晶固体膜の導電 性回路の光微細パターニングなど、新しい光機 能材料の開発に応用されることが期待される。

本助成金による主な発表論文、著書名

- "Photochromic dinuclear iridium (iii) complexes having phenoxyl-imidazolyl radical complex derivatives", Yoshinori Okayasu, Takuya Miyahara, Rintaro Shimada, Yuki Nagai, Akira Sakamoto, Jiro Abe and Yoichi Kobayashi, *Chem. Commun.* 2023, 59, 8850-8853.
- "Quasi-Reversible Photoinduced Displacement of Aromatic Ligands from Semiconductor Nanocrystals", Daisuke Yoshioka, Yusuke Yoneda, I-Ya Chang, Hikaru Kuramochi, Kim Hyeon-Deuk, and Yoichi Kobayashi, ACS Nano 2023, 17, 11309-11317.
- "Excited State Engineering in Ag₂₉ Nanocluster through Peripheral Modification with Silver (I) Complexes for Bright Near-Infrared Photoluminescence", Wataru Ishii, Yoshinori Okayasu, Yoichi Kobayashi, Rika Tanaka, Shohei Katao, Yoshiko Nishikawa, Tsuyoshi Kawai, and Takuya Nakashima, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 11236-11244.
- 4) "Near-Infrared-Light Triggered Electron Transfer from Ag2S Nanocrystals to Perylene Bisimide", Yuki Nagai, Tadashi Watanabe, Daisuke Yoshioka, Yoshinori Okayasu, Naoto Tamai, Yoichi Kobayashi, ECS J. Solid State Sci. Technol. 2022, 11, 101001.
- 5) "半導体ナノ結晶によるペリレンビスイミドの 高励起状態の電子抽出",吉岡大祐・小林洋一, ナノ学会会報,2022年9月,第21巻,第1号